⁰⁸ Топологический фазовый переход развязывания квазидвумерных вихревых пар в La_{1-v}Sm_vMnO_{3+ δ} (y = 0.85 и 1.0)

© Ф.Н. Буханько, А.Ф. Буханько

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАНУ, 03680 Киев, Украина e-mail: afbuhanko@mail.ru

(Поступило в Редакцию 11 декабря 2015 г.)

Обнаружены характерные признаки универсального скачка Нельсона-Костерлитца плотности квазидвумерной сверхпроводящей жидкости в температурных зависимостях dc намагниченности образцов La_{1-y}Sm_yMnO_{3+δ} с концентрацией самария y = 0.85 и 1.0, измеренных в магнитных полях с напряженностью 100 Oe $\leq H \leq 3.5$ kOe. В образце с y = 0.85 с ростом температуры наблюдалась характерная для диссоциации 2D-вихревых пар серповидная сингулярность кривых dc намагниченности вблизи критической температуры $T_{\rm KT} \equiv T_c \cong 43$ развязывания пар вихрь-антивихрь, не зависящей от напряженности Hизмерительного поля. Подобная сингулярность была найдена также в образце с концентрацией самария y = 1.0 при значительно меньшей температуре $T_{\rm KT} \cong 12$ К. Полученные экспериментальные результаты объяснены в рамках существующих представлений о топологическом фазовом переходе Костерлитца-Таулесса диссоциации 2D-вихревых пар в квазидвумерной сетке джозефсоновских слабых связей.

Введение

Известно, что в двумерных (2D) системах при всех температурах невозможно спонтанное упорядочение с возникновением дальнего порядка обычного типа. Исследования критического поведения в рамках классической двумерной ХҮ модели показали, что при достаточно низких температурах в 2D-системе возникает фаза с новыми свойствами, в которой отсутствует обычный дальний порядок. Ряд теорий предсказывает низкотемпературный район, который характеризуется как "фаза" критических точек с непрерывно меняющимися критическими индексами. В пределах этой фазы корреляционные функции параметра порядка спадают на больших расстояниях по степенным законам, тогда как при температурах выше критической величины корреляции затухают экспоненциально. Костерлитц и Таулесс предсказали новый фазовый переход (ФП) типа порядок-беспорядок в двумерной решетке спинов, который характеризуется установлением в плоской системе топологического дальнего порядка [1-3]. Элементарными возбуждениями, допускающими существование в двумерных решетках спинов топологического дальнего порядка, являются спиновые волны и пары связанных вихревых структур противоположного знака, среднее расстояние между которыми характеризуется длиной когерентности. В низкотемпературной фазе пары 2D-вихрей связаны в диполи, тогда как в высокотемпературной фазе пары вихрь-антивихрь развязаны. Спонтанно возникающая при температурах выше Т_{КТ} плазма свободных 2D-вихрей разрушает топологический дальний порядок, что приводит к качественному изменению макроскопических свойств всей системы, сопровождающемуся аномальными эффектами. По своим свойствам

плазма свободных 2D-вихрей аналогична двумерному кулоновскому газу заряженных частиц.

В рамках двумерной ХҮ модели был предсказан универсальный скачок плотности сверхтекучей жидкости $\rho_s^{2D}(T)$ при нагреве ⁴Не-пленок вблизи критической температуры Т_с [4]. Нельсон и Костерлитц показали, что развязывание 2D-вихревых пар сопровождается универсальным скачком $\rho_s^{2D}(T)$ к нулю. Предсказания теории были подтверждены измерениями $\rho_s^{\rm 2D}(T)$ в пленках сверхтекучего гелия ⁴Не [5,6]. Динамическая теория ФП пленок ⁴Не в сверхтекучее состояние была построена в [7]. Как было показано в [8], логарифмическое взаимодействие между двумерными вихревыми флуктуациями параметра порядка имеет место и в тонких сверхпроводящих пленках толщиной $d \ll \lambda$, что позволило предположить существование в них КТ-перехода с температурой $T_{2D} \leq T_c$ перехода в сверхпроводящее (СП) состояние [9-11]. Термическая диссоциация 2D-вихревых пар в тонких сверхпроводящих пленках была обнаружена в ряде экспериментальных работ при температурах выше критической *T*_{2D} [12–20].

Открытие высокотемпературной сверхпроводимости в оксидных сверхпроводниках, обладающих четко выраженной слоистой структурой, заставило многих исследователей искать причину высоких температур СП-перехода в анизотропии параметра порядка, вызванной квазидвумерностью этих соединений. Одним из доказательств квазидвумерности оксидных сверхпроводников являются характерные признаки фазового перехода Костерлитца—Таулесса, обнаруженные в ряде экспериментальных работ [21–35]. Возможность существования КТ-перехода с высокой температурой $T_{\rm KT} \equiv T_c$, соответствующей температуре диссоциации 2D-вихревых пар в сверхпроводящих слоях, была предсказана в [27–32,36]. Известно, что высокотемпературные сверхпроводники имеют слоистую структуру, состоящую из сдвоенных CuO_2 -плоскостей с джозефсоновским взаимодействием между слоями. Если CuO_2 -плоскости эффективно развязаны, то при температурах ниже T_{c0} в них должны спонтанно возникать 2D-вихревые флуктуации, аналогичные флуктуациям фазы параметра порядка в тонких сверхпроводящих пленках. Вопрос о том, при каких условиях в сверхпроводящих CuO_2 -слоях могут существовать квазидвумерные вихревые флуктуации, является одной из центральных проблем теории высокотемпературных сверхпроводников.

Ранее в наших работах [36] был проведен анализ температурных и полевых зависимостей намагниченности образцов манганитов $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ (y = 0.85, 1.0) в интервале температур $4.2 \, {
m K} \le T \le 100 \, {
m K}$ и магнитных полей $100 \,\mathrm{Oe} \le H \le 5 \,\mathrm{kOe}$. Найдены характерные признаки существования высокотемпературной сверхпроводимости в виде аномального диамагнетизма и макроскопического квантования магнитных свойств, индуцированного изменениями температуры и поля в образцах со смешанным основным состоянием спинов/зарядов ионов марганца Mn³⁺/Mn⁴⁺ в виде трех микрофаз: спиновой, электрон-дырочной квантовых жидкостей и флуктуирующего квазидвумерного антиферромагнетика (АФМ). Были детально исследованы квантовые осцилляции намагниченности и магнитной восприимчивости в слабых магнитных полях $H \leq 1 \,\mathrm{kOe}$ вблизи критических температур фазовых переходов в синусоидально-модулированные низкоразмерные АФМ-состояния А- и СЕ-типов. Показано, что исследованные образцы имеют свойства многокомпонентного сверхпроводящего композита, в котором при температурах T < 60 К в слабых магнитных полях сосуществуют в аb-плоскостях флуктуирующие зарядовые и АФМ-корреляции А- и СЕ-типов со свойствами спиновой жидкости и небольшая доля локальной сверхпроводящей фазы в виде отдельных наномасштабных 2D-сверхпроводящих контуров (наноячеек). В отличие от обычных dc-сквидов квантовые осцилляции магнитных свойств индуцируются в СП-контурах с ростом температуры не изменениями напряженности внешнего магнитного поля, а изменениями температуры образца. Другими словами, они соответствуют тепловым возбуждениям сверхпроводящей жидкости в аb-плоскостях при ее переходе с ростом температуры из энергетического состояния $n\Phi_0$ на вышележащий квантовый уровень $(n+1)\Phi_0$. Предполагалось, что в исследованных образцах при температурах ниже 60 К реализуется новое неоднородное состояние допированных манганитов типа магнито-электронных жидких кристаллов.

В настоящей работе исследовалась аномалия температурных зависимостей намагниченности M(T) в образцах La_{1-y}Sm_yMnO_{3+ δ} с концентрацией самария y = 0.85 и 1.0 в измерительных магнитных полях 100 Oe $\leq H \leq 5.5$ kOe. Показано, что аномалия вызвана топологическим фазовым переходом Костерлитца–Таулесса диссоциации 2D-вихревых пар в сверхпроводящей квазидвумерной сетке джозефсоновских контактов, расположенной в аb-базисных плоскостях исследованных образцов. Обнаруженная вблизи критической температуры T_{KT} < T_{c0} серповидная аномалия намагниченности, по-видимому, вызвана универсальным скачком Нельсона-Костерлитца плотности $\rho_s^{2D}(T)$ сверхпроводящей жидкости в *ab*-плоскостях, аналогичным скачку плотности сверхтекучей жидкости, хорошо исследованному ранее в 2D-квантовых жидкостях, электронных жидких кристаллах и квазидвумерных обычных и высокотемпературных сверхпроводниках. Скачок плотности сверхпроводящей жидкости $\rho_s^{2D}(T)$ сопровождается экспоненциальным спадом плотности критического тока $i_c(T)$ в 2D-сетке сверхпроводящих наноячеек при температурах $T > T_{\rm KT}$, который подобен хорошо известному резкому падению плотности критического тока $i_c(T)$ в 2D-искусственных сверхпроводящих построениях с джозефсоновскими контактами. Появление таких СП-наноструктур в исследованных образцах, по-видимому, связано с металлизацией доменных стенок синусоидально-модулированных 2D АФМ-структур.

Методика эксперимента

образцов Серия манганитов $La_{1-\nu}Sm_{\nu}MnO_{3+\delta}$ $(0 \le y \le 1, \delta \sim 0.1)$ была получена из высокочистых окислов лантана, самария и электролитического марганца, взятых в стехиометрических соотношениях. Синтезированный порошок прессовали под давлением 10 kbar в диски диаметром 6 mm, толщиной 1.2 mm и спекали на воздухе при температуре 1170°C в течение 20 h с последующим снижением температуры со скоростью 70°C/h. Полученные таблетки представляли собой однофазную по рентгеновским данным керамику. Рентгенографические исследования проводили при 300 К на дифрактометре ДРОН-1.5 в излучении NiK_{a1+a2}. Симметрия и параметры кристаллической решетки определялись по положению и характеру расщепления рефлексов псевдокубической решетки типа перовскита. Измерения температурных M(T)и полевых M(H) зависимостей намагниченности образцов производились на вибрационном магнитометре VSM EGG, Princeton Aplied Reserch и непромышленном вибрационном магнитометре в интервале температур 4.2-250 К в диапазоне постоянных магнитных полей $7 \,\mathrm{Oe} \le H \le 6 \,\mathrm{kOe}$. Критическая температура Кюри перехода образцов в ферромагнитное состояние определялась по точке перегиба кривых M(T), а критические температуры переходов в фрустрированное АФМ-состояние определялись по положению пиков кривых M(T). Температурные зависимости намагниченности M(T) были измерены при нагреве образцов, предварительно охлажденных до 4.2 К в нулевом поле (ZFC-режим), а также во внешнем поле (FC-режим).

Четким свидетельством существования в фрустрированных манганитах $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ с концентрацией самария $y \ge 0.85$ локальной высокотемпературной сверхпроводимости являются обнаруженные нами ранее аномальный диамагнетизм и квантовые осцилляции намагниченности в виде небольших периодических ступенек, возникающих на кривых M(T) вблизи критических температур T_A и T_{CE} фазовых переходов в низкоразмерные синусоидально-модулированные АФМ-состояния A- и CE-типов [36]. Эти особенности хорошо выражены вблизи антиферромагнитных ФП в виде серии близких по величине и форме периодических ступенек (разрывов) намагниченности, которые появля-



Рис. 1. a — квантовые осцилляции намагниченности M(T) образца La_{1-y}Sm_yMnO_{3+ δ} с концентрацией самария y = 0.85 при температурах чуть ниже $T_{c0} \sim 60$ К появления ВТСП в отдельных 2D-петлях, расположенных в ab-плоскостях; ZFC-режим измерений в магнитном поле с напряженностью H = 105 Oe. b — сингулярность температурной зависимости намагниченности образца La_{1-y}Sm_yMnO_{3+ δ} с концентрацией самария y = 0.85 в виде излома кривой M(T) вблизи критической температуры $T_{\rm KT} \sim 43$ К фазового перехода Костерлитца–Таулесса; ZFC-режим измерений в магнитном поле H = 105 Oe.

ются в виде ряби "сверхнамагниченности", наложенной на непрерывные кривые M(T). Предполагалось, что в образцах с у = 0.85 при температурах ниже критической температуры начала перехода СП-композита в сверхпроводящее состояние $T_{c0} \sim 60 \,\mathrm{K}$ существуют наномасштабные сверхпроводящие контуры (наноячейки), которые с понижением температуры могут формировать 2D-сетку наноячеек с джозефсоновскими слабыми связями при критической температуре $T_c < T_{c0}$ перехода образца в когерентное сверхпроводящее состояние. Индуцированные ростом температуры образцов ступенчатые особенности кривых M(T) при температурах как ниже, так и выше критических температур ФП были объяснены изменениями внешнего магнитного потока через отдельные СП-наноячейки вследствие изменений dc-намагниченности образцов различного знака вблизи критических температур АФМ-фазовых переходов. Форма ступенек и направление периодических скачков намагниченности сильно зависели от напряженности Н внешнего магнитного поля.

Согласно представленным на рис. 1, а и 2, а кривым M(T), измеренным в dc-магнитных полях H == 105 Oe, 350 Oe в ZFC-режиме, квантовые осцилляции намагниченности в образце с у = 0.85 возникают при температурах как выше, так и ниже критической температуры ТА перехода образца в флуктуирующее АФМ-состояние А-типа и сильно зависят от напряженности измерительного поля. В магнитом поле *H* = 105 Ое осцилляции появляются при температурах ниже $T_{c0} \sim 60 \,\mathrm{K}$ (рис. 1, *a*), тогда как в поле 350 Ое периодические скачки намагниченности появляются при более низкой температуре $T_{c0} \sim 55.4 \, {
m K}$ (рис. 2, *a*). Предполагается, что температура $T_{c0} \sim 60 \,\mathrm{K}$ соответствует началу перехода малой части образца с у = 0.85 в сверхпроводящее состояние при понижении его температуры. Аналогичные серии квантовых осцилляций dc-намагниченности были получены также при измерениях намагниченности в образце с у = 1.0 при температурах ниже ~ 51 К (рис. 3, *a* и 4, *a*). Отличительными свойствами обнаруженных в фрустрированных манганитах $La_{1-v}Sm_vMnO_{3+\delta}$ (y = 0.85, 1.0) квантовых осцилляций намагниченности являются: их появление при относительно близких критических температурах $T_{c0} \le 60 \, {
m K}$, периодичность по температуре измерений, а также сильная зависимость периода, формы и размера осцилляций от напряженности Н измерительного поля. Обнаруженные нами квантовые осцилляции намагниченности можно объяснить появлением при температурах ниже Т_{с0} сверхпроводящих контуров (наноячеек) с джозефсоновскими контактами. Отдельный сверхпроводящий джозефсоновский контур во внешнем dc-магнитном поле H при $T < T_{c0}$ можно рассматривать как СП-кольцо, содержащем джозефсоновский переход, процессы в котором хорошо изучены [37]. В отличие от исследованных ранее сверхпроводящих колец со слабой связью, возбуждаемых магнитным полем [37], в нашем случае периодические осцилляции индуци-

T, К **Рис. 2.** *a* — квантовые осцилляции намагниченности M(T) образца La_{1-y}Sm_yMnO_{3+ δ} с концентрацией самария *y* = 0.85 при температурах чуть ниже $T_{c0} \sim 55.4$ К появления ВТСП в отдельных 2D-петлях, расположенных в *ab*-плоскостях; ZFC-режим измерений в магнитном поле с напряженностью H = 350 Ое. *b* — серповидная сингулярность температурной зависимости намагниченности образца La_{1-y}Sm_yMnO_{3+ δ} с концентрацией самария *y* = 0.85 вблизи критической температуры $T_{\rm KT} \sim 43$ К фазового перехода Костерлитца–Таулесса диссоциации вихревых пар в 2D-сетке джозефсоновских слабых связей; ZFC-режим измерений в магнитном поле H = 350 Ое.

руются не изменениями напряженности H внешнего магнитного поля, а изменениями температуры образца. Другими словами, они соответствуют тепловым возбуждениям сверхпроводящей жидкости в наномасштабных СП-контурах при их переходах с ростом температуры из энергетического состояния $n\Phi_0$ на вышележащий квантовый уровень $(n + 1)\Phi_0$.

Результаты проведенных в работах [36] исследований аномалий температурных и полевых зависимостей dc-намагниченности образцов с концентрацией самария y = 0.85 и 1.0 в интервале температур 4.2–100 К свидетельствуют о существовании в этих образцах сетки СП-джозефсоновских контуров со средним линейным размером $\langle a \rangle \sim 1.4 \cdot 10^2$ nm. Присутствие подобных джозефсоновских наноструктур (микродоменов с разме-

рами порядка длины когерентности) было обнаружено ранее во многих ВТСП купратах и имеет различную природу. Так, например, в работе [38] по данным измерений сопротивления и намагниченности образцов были обнаружены джозефсоновские наноструктуры в YBCO (δ < 0.1) тонких пленках с высоким критическим током Јс. Подобные наноструктуры были обнаружены также в монокристаллах ҮВСО при исследовании структуры кристаллической решетки при 300 К с помощью электронной микроскопии высокого разрешения [39]. Помимо хорошо известных границ двойникования, расположенных на расстоянии ~ 500 Å, было обнаружено существование в ав-плоскостях наноячеек с линейными размерами ~ 10-20 Å. Наноячейки формируют неравномерную сетку со стенками ячеек, ориентированными вдоль направлений, составляющих угол 45° по отношению к осям (100) и (010). Появление наноструктуры кристаллической решетки автор связывает с локальным возмущением распределения зарядовой плотности в аb-плоскостях. Это, по-видимому, универсальное свойство для YBCO ($\delta < 0.1$) образцов, приготовленных в различных условиях. Наноячейки связываются в сетку слегка разориентированных доменов, чтобы уменьшить внутренние напряжения. Грубый порядок наноячеек в каждом исследованном кристалле подразумевает воздействие полей дальнодействующих деформаций кристаллической решетки. Двумерные сетки наноячеек скоррелированы вдоль с-оси. Эти экспериментальные результаты поддерживают дискретные теоретические модели, предложенные для объяснения различных физических свойств высокотемпературных сверхпроводников: теплоемкость в магнитном поле, сопротивление магнитного потока, фазовые переходы в сверхпроводнике с колонообразными дефектами, эффект флуктуаций фазы. В каждом случае использовалось дискретное представление, в котором сверхпроводящие слои были описаны как построения из очень маленьких "гранул" с размерами, сравнимыми с длиной когерентности и связанных вместе джозефсоновскими переходами. Результаты экспериментальных и теоретических исследований позволили предположить, что джозефсоновские наноструктуры в *ab*-плоскостях YBCO должны действовать на все физические свойства этого высокотемпературного сверхпроводника. Мы предполагаем, что обнаруженное в настоящей работе появление квантовых осцилляций намагниченности в образцах $La_{1-v}Sm_vMnO_{3+\delta}$ (y = 0.85, 1.0) при температурах ниже $\sim 60 \, {\rm K}$ является следствием формирования сетки СП-наноячеек в аb-плоскостях, вызванного металлизацией доменных стенок пространственно-модулированных АФМ-структур А- и СЕ-типов.

Можно было ожидать, что переход ансамбля квазидвумерных СП-наноячеек с понижением температуры в когерентное сверхпроводящее состояние при критической температуре $T_c < T_{c0}$, должен найти свое проявление в виде серповидной сингулярности температурных зависимостей намагниченности образцов с y = 0.85 и 1.0. Предполагается существование аномалии магнит-





Рис. 3. a — квантовые осцилляции намагниченности M(T) образца $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ с концентрацией самария y = 1.0 при температурах чуть ниже $T_{c0} \sim 51$ К появления ВТСП в отдельных 2D-петлях, расположенных в ab-плоскостях; ZFC-режим измерений в магнитном поле с напряженностью H = 105 Ое. Наличие двух скачков намагниченности 1 и 2 при очень близких температурах обусловлено неоднозначностью магнитного потока в сверхпроводящей петле. b — серповидная сингулярность температурной зависимости намагниченности образца $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ с концентрацией самария y = 1.0 вблизи критической температуры $T_{\rm KT} \sim 12$ К фазового перехода Костерлитца–Таулесса диссоциации вихревых пар в 2D-сетке джозефсоновских слабых связей; ZFC-режим измерений в магнитном поле H = 105 Ое.

ных свойств, вызванной диссоциацией 2D-вихревых пар в сетке связанных джозефсоновским взаимодействием СП-наноячеек при температурах вблизи критической температуры $T_{\rm KT} \equiv T_c$ хорошо известного в двумерных сверхпроводниках топологического фазового перехода Костерлитца—Таулесса. Согласно многочисленным литературным данным [8–35], развязывание 2D-вихревых пар сопровождается резким падением двумерной плотности $\rho_s^{\rm 2D}(T)$ нейтральных сверхтекучих жидкостей или плотности критического тока $i_c(T)$ в двумерных сетках джозефсоновских слабых связей. Полученные в настоящей работе экспериментальные результаты подтверждают это предположение. Как видно из рис. 1, *b*, в

образце с концентрацией самария y = 0.85 аномалия dc-намагниченности возникает в измерительном поле H = 105 Oe в виде излома температурной зависимости намагниченности M(T) вблизи температуры $T_{\rm KT} \cong 43$ K. Рост напряженности поля H до 350 Oe не привел к заметному изменению $T_{\rm KT}$, но форма аномалии температурной зависимости намагниченности M(T) вблизи $T_{\rm KT}$ приобрела классическую серповидную форму в виде плато в интервале температур 30 K < T < 43 K и резкого падения намагниченности в узком интервале температур 43 K < T < 48 K (рис. 2, b), характерную для универсального скачка Нельсона–Костерлитца [4] двумерной плотности $\rho_s^{2D}(T)$ сверхпроводящей жидкости. Дальнейший рост напряженности магнитного поля до



Рис. 4. a — квантовые осцилляции намагниченности M(T) образца $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ с концентрацией самария y = 1.0 при температурах чуть ниже $T_{c0} \sim 49.5$ К появления ВТСП в отдельных 2D-петлях, расположенных в ab-плоскостях; ZFC-режим измерений в магнитном поле с напряженностью H = 350 Ое. Наличие двух скачков намагниченности I и 2 при очень близких температурах обусловлено неоднозначностью магнитного потока в сверхпроводящей петле. b — серповидная сингулярность температурной зависимости намагниченности образца $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ с концентрацией самария y = 1.0 вблизи критической температуры $T_{\rm KT} \sim 12$ К фазового перехода Костерлитца–Таулесса диссоциации вихревых пар в 2D-сетке джозефсоновских слабых связей; ZFC-режим измерений в магнитном поле H = 350 Ое.

~ 1 кОе приводит к размазыванию сингулярности намагниченности. Более четко серповидный скачок двумерной плотности $\rho_s^{\rm 2D}(T)$ проявился в температурных зависимостях M(T) образца с y = 1.0 вблизи значительно более низкой критической температуры $T_{\rm KT} \cong 12$ К. Как хорошо видно из рис. 3, b и 4, b, в измерительных полях H = 100 и 350 Ое в узком интервале низких температур 8 K < T < 12 К наблюдается плато температурной зависимости dc-намагниченности образца, тогда как в интервале более высоких температур 12 K < T < 16 К намагниченность экспоненциально падает.

Хорошо известно, что макроскопическим параметром 2D-сетки слабых связей, который можно измерить экспериментально, является кинетическая индуктивность $L_k(T) = \hbar/2ei_c(T)$. В работе [25] было показано, что в образцах сверхпроводящей керамики ҮВСО реализуется 2D-сетка джозефсоновских контактов, для которой переход в когерентное сверхпроводящее состояние вблизи T_c сопровождался скачком $L_k^{-1}(T)$, пропорциональным степени фазовой когерентности и критическому току $i_c(T)$. Согласно измеренным температурным зависимостям $L_k^{-1}(T)$, плотность критического тока $i_c(T)$ в 2D-сверхпроводящей сетке при $T > T_c$ обращается в нуль, тогда как при $T < T_c$ критический ток или остается постоянным при понижении температуры, или линейно растет. Такое поведение плотности критического тока $i_c(T)$ в 2D-сверхпроводящей сетке при $T \sim T_c$ хорошо согласуется с предсказаниями моделей топологического фазового перехода Костерлитца-Таулесса и исследованным в настоящей работе поведением dc-намагниченности в манганитах $La_{1-v}Sm_vMnO_{3+\delta}$ (y = 0.85, 1.0) вблизи T_c .

Многие необычные резистивные свойства ҮВСО керамики связаны с флуктуациями параметра порядка, вызванными делением каждой из сверхпроводящих плоскостей CuO₂ границами гранул и доменов двойникования на сверхпроводящие острова, связанные джозефсоновским взаимодействием. Если исходить из модельных представлений работы [28], свойства стопки сверхпроводящих плоскостей CuO2 аналогичны свойствам изолированной сверхпроводящей CuO2-плоскости при достаточно слабой связи между плоскостями. Наличие деления такой эффективной плоскости на слабосвязанные сверхпроводящие острова (наноячейки) приводит к предположению о том, что аномальные свойства ҮВСО керамики в интервале температур $T_{\rm KT} \leq T \leq T_{c0}$ могут быть описаны в рамках модели 2D-сетки джозефсоновских связей. В сетках с джозефсоновскими контактами переход островков в сверхпроводящее состояние не означает наличие фазового перехода. Требуется еще более низкая температура для возникновения фазовой когерентности всей системы. В классических 2D-построениях этот переход есть переход типа Костерлитца-Таулесса [40-42]. В работе [40] исследовались температурные зависимости электросопротивления R(T) искусственных 2D-построений PbBi/Cu контактов. После первоначального резкого падения сопротивления при температурах ниже T_{cs} наблюдалось медленное уменьшение Rс понижением температуры. В рамках простой модели эффекта близости сверхпроводник-нормальный металл-сверхпроводник (S-N-S) контакт при температурах ниже T_{cs} должен иметь ненулевой критический ток через контакт, но тепловой шум разрушает фазовую когерентность СП-параметра порядка в нормальном слое. Эффект близости объясняет медленное понижение сопротивления тонкого слоя Си в контакте при температурах ниже T_{cs} перехода островков в СП-состояние. Окончательный резкий переход 2D-сетки S-N-S-контактов в состояние с нулевым сопротивлением при $T < T_c$ был описан в рамках модели развязывания 2D-вихрей с помощью ХҮ модели, в которой энергия джозефсоновской связи $E_J = \hbar i_c(T)/2e$ сильно зависит от температуры. Вольт-амперные *I-V* кривые сетки S-N-S-контактов имеют классическую форму $V \propto I^{a(T)}$, характерную для топологического КТ-перехода, вызванного развязыванием 2D-вихрей, при котором показатель степени $a(T) \propto 1 + i_c(T)$ имеет резкий скачок вблизи T_c от 1 до 3 с последующим линейным ростом при дальнейшем понижении температуры. Таким образом, основным макроскопическим параметром, определяющим аномальное поведение как магнитных, так и резистивных свойств 2D-сетки джозефсоновских контактов вблизи температуры $T_{\rm KT} \equiv T_c$, является плотность критического тока $i_c(T)$.

Высокотемпературный сверхпроводящий купрат можно рассматривать как стопку CuO2-слоев, связанных джозефсоновским туннелированием. Авторы [27] на основе своего теоретического расчета сделали вывод, что 2D-вихревые флуктуации могут существовать в системе CuO2-слоев только при высокой анизотропии электронных свойств, определяемой отношением эффективных масс свободных носителей заряда $m_{\parallel}^*/m_{\perp}^*$, которое может быть получено из измерений dc-проводимости в ав-плоскостях и вдоль с-оси. Согласно предложенной модели, для слоистых сверхпроводников с сильной анизотропией электронных свойств типа BSCCO $(m_{\parallel}^*/m_{\perp}^*=3\cdot 10^3)$ и ТВССО $(m_{\parallel}^*/m_{\perp}^*=5\cdot 10^3)$ имеется возможность существования в них при температурах ниже Т_{с0} квазидвумерных вихревых флуктуаций. По оценкам, сделанным в [27], анизотропия dc-проводимости в YBCO $(m_{\parallel}^*/m_{\perp}^*=25)$ на три порядка меньше, чем в BSCCO, поэтому можно ожидать существование более значительной джозефсоновской связи между CuO₂-слоями, которая должна воспрепятствовать развязыванию пар вихрь-антивихрь. Однако согласно альтернативной модели расчета энергии пар 2D-вихрей в YBCO [28], развязывание вихревых пар вблизи температуры СП-перехода, индуцированное нагревом образца, вполне возможно, особенно в случаях ослабления межслойного взаимодействия флуктуациями. В основе этой модели лежит предположение, что в сверхпроводниках типа ҮВСО с относительно небольшой анизотропией электронных свойств межплоскостная джозефсоновская

95

связь приводит к перенормировке $\rho_s^{2D}(T)$, в результате которой двумерная плотность сверхтекучей компоненты становится достаточно большой для существования квазидвумерных флуктуаций вблизи T_{c0} . Согласно новой оценке критической температуры КТ-перехода в YBCO, было получено значение $T_{\text{KT}} = 44$ K, что нашло свое подтверждение в ряде экспериментальных работ. Измеренное в настоящей работе значение критической температуры $T_{\text{KT}} \cong 43$ K в образце La_{1-y} Sm_yMnO_{3+ δ} с концентрацией самария y = 0.85 практически совпадает с теоретическим расчетом T_{KT} работы [28] для YBCO, поэтому имеет смысл более подробно остановиться на хорошо известных экспериментальных свидетельствах КТ-перехода в этом соединении, связанных с его квазидвумерностью.

Характерные признаки КТ-перехода были обнаружены в транспортных и магнитных свойствах монокристаллов, керамики и гранулярных пленок ҮВСО [21-26]. Одним из основных доказательств такого перехода принято считать различные проявления универсального скачка Нельсона-Костерлитца двумерной плотности сверхтекучей компоненты $ho_s^{
m 2D}(T)$ к нулю при повышении температуры до критического значения ТКТ. Этот скачок является следствием развязывания вихревых пар и сопровождается возникновением резистивности за счет генерации плазмы свободных 2D-вихрей. Для тонких пленок обычных сверхпроводников это приводит к появлению остаточного сопротивления в виде хвоста резистивности при температурах ниже Тсо и скачку показателя степени n(T) нелинейных вольт-амперных характеристик (BAX). Нелинейные BAX при температурах ниже $T_{\rm KT}$ были обнаружены в монокристаллах ҮВСО [21] и в керамике [22]. В монокристалле ҮВСО скачок показателя степени происходил при температуре $T_{\rm KT} \approx 80 \, {\rm K}$, тогда как переход в сверхпроводящее состояние осуществлялся в интервале температур 81.6-83.3 К чуть выше $T_{\rm KT}$. Измерения dc-сопротивления R(H, T), проведенные в монокристаллах ҮВСО с температурой начала СП-перехода $T_{c0} \cong 82 \,\mathrm{K}$ [21], свидетельствуют о значительной анизотропии сопротивления в нормальном состоянии и наличии квазидвумерности сверхпроводимости с корреляционной длиной куперовской пары $\xi_c = 4.8$ Å при $T \leq T_{c0}$ меньшей, чем расстояние между СиО2-слоями. Тщательное измерение поведения dc-сопротивления $R_{ab}(T)$ в *ab*-плоскостях позволило установить, что переход монокристаллов ҮВСО в сверхпроводящее состояние имеет все основные признаки перехода Костерлитца-Таулесса: экспоненциальнокорневую зависимость $R_{ab}(T) \sim R_N \exp(\pi \beta \tau^{-1/2})$ и скачок Нельсона-Костерлитца показателя степени n(T)для нелинейных ВАХ при критической температуре $T_{\rm KT} \cong T_{c0} = 82$ К. По мнению авторов, межплоскостное магнитное взаимодействие между обычными 2D-вихрями должно приводить к образованию устойчивых 3D-линий магнитной индукции. Поэтому было высказано предположение, что за КТ-переход ответственны квазидвумерные солитоны, возникающие в СиО2-слоях в виде элементарных возбуждений антиферромагнитной сверхтекучей жидкости. При анализе температурных зависимостей ВАХ в гранулярных пленках ҮВСО [23] была обнаружена флуктуационная резистивность в очень узком интервале температур между $T_{\rm KT} = 86.3 \, {\rm K}$ и $T_{c0} = 86.8 \, {\rm K}$, что соответствует малой величине параметра, определяющего область критических флуктуаций — $\tau_{\rm KT} = (T_{c0} - T_{\rm KT})/T_{\rm KT} \approx 6 \cdot 10^{-3}$. В то же время, согласно результатам исследования ВАХ в текстурированных пленках ҮВСО толщиной 0.3-0.7 µm с различным качеством кристаллической структуры [24], параметр $\tau_{\rm KT}$ может меняться в очень широком интервале значений от 0.02 до 1.5, что вступает в противоречие с общепринятым мнением о малости области с критическими флуктуациями в сверхпроводниках с небольшой анизотропией. Чтобы устранить это противоречие, авторы высказали предположение, что в исследованных пленках структурный беспорядок в виде случайных разориентаций кристаллов разрушает токоперенос между сверхпроводящими островами, что приводит к росту эффективной анизотропии всей системы. Дефектность структуры пленок приводит также к размазыванию и исчезновению скачка показателя степени нелинейных ВАХ.

Динамические свойства квазидвумерных флуктуаций в YBCO исследованы значительно меньше. Впервые проявление КТ-перехода в слабом переменном магнитном поле было обнаружено на частоте 1.3 kHz при изучении комплексного импеданса УВСО пленок [25]. При изучении ас-комплексного импеданса Z(T) в эпитаксильных пленках YBCO толщиной 500 Å индукционным методом КТ-переход был обнаружен в виде сингулярности $\lambda^{-2}(T)$. Однако этот переход скорее связан с обычными двумерными флуктуациями тонкой сверхпроводящей пленки и не отражает слоистую структуру YBCO. В работе [25] наблюдались скачок мнимой части комплексного импеданса Im Z и узкий пик поглощения вблизи температуры T_{KT} = 76 К в гранулярных пленках YBCO с $T_{c0} \approx 90 \,\mathrm{K}$ толщиной $d \approx 4 \,\mu\mathrm{m}$ на частоте 1.3 kHz. Эти особенности были интерпретированы как КТ-переход в 2D-периодической сетке джозефсоновских контактов, сформированной СП-гранулами в пленках. Обнаруженный позднее скачок $\lambda^{-2}(T)$ в ориентированных пленках YBCO толщиной 200 Å вблизи 79 К был объяснен критическим поведением, вызванным перкаляционной природой перехода в сверхпроводящее состояние в гранулярных пленках. Однако наблюдение аналогичного скачка мнимой части комплексного импеданса Im Z и узкого пика поглощения вблизи температуры $T_{\rm KT} = 88 - 89 \, {\rm K}$ в керамике YBCO с $T_{c0} = 91 \, {\rm K}$ на частоте 9 GHz четко свидетельствует о наличии КТ-перехода в этом соединении. Было установлено, что поведение кинетической индуктивности пленок $L_k(T)$ и поглощение энергии ас-поля удивительно похожи на поведение аналогичных динамических параметров искуственных плоских сеток джозефсоновских контактов вблизи КТ-перехода: в толстой гранулярной пленке с $T_{c0} = 92\,\mathrm{K}$ обнаружен скачок величины $L_k^{-1}(T)$ к нулю в узком интервале температур вблизи *T*_{KT} = 76 K и узкий слабый пик поглощения энергии ас-поля. Относительно большую величину параметра $\tau_c \cong 0.2$, по-видимому, можно отнести к значительной разориентации гранул в СП-пленке. В этой связи вызывает удивление малая ширина интервала температур, в котором происходит фазовый переход, что характерно для систем с высокой однородностью сверхпроводящих свойств. Более удовлетворительное значение $\tau_c \cong 5 \cdot 10^{-2}$ было получено при исследовании температурных зависимостей комплексного импеданса пленок ҮВСО в интервале частот 2-20 MHz [26]. Были обнаружены аномалии импеданса в виде скачка реактивной компоненты в узком интервале температур вблизи T_{KT} = 86 K и узкого пика поглощения энергии ас-поля. Более того, при температурах *T* > *T*_{c0} = 90 К наблюдались признаки флуктуационной парапроводимости, характерной для двумерных сверхпроводников. Обнаруженный в слабых полях $h \le 0.01$ Ое узкий пик дополнительного поглощения не зависел от напряженности и частоты измерительного поля. Следует особо отметить, что аномалии Z(T), обнаруженные в [25,26] вблизи T_{KT} в пленках различного качества, сосредоточены в узком интервале температур. Это позволяет предположить, что дефектность структуры меньше проявляется при измерениях динамических магнитных свойств, чем при изучении транспортных свойств.

Обращает на себя внимание обнаруженное в настоящей работе значительное снижение критической температуры $T_{\rm KT}$ на $\sim 30\,{
m K}$ в образцах La_{1-v}Sm_vMnO_{3+ δ} (y = 0.85, 1.0) при относительно небольшом изменении концентрации самария. Такое поведение можно объяснить только появлением "гигантских" флуктуаций заряда в *аb*-плоскостях в образцах с концентрацией самария у, близкой к единице. Известно, что температура перехода T_{KT} в 2D-сетке джозефсоновских связей порядка энергии связи Е_J джозефсоновского контакта. Когда размеры островов малы и величины соответствующих им емкостей С₀ также малы, то энергия зарядов на этих островах $E_{c0} \equiv e^2/2C_0$ оказывается большой, и роль квантовых флуктуаций заряда резко возрастает [40-42]. Эти флуктуации подавляют температуру развязывания пар вихрь-антивихрь и при малой величине $E_J/E_{c0} \le 1$ даже при T = 0 в образце отсутствует фазовая когерентность всей системы. Свойства классических 2D-построений с $E_J \gg E_{c0}$ описываются вихрями (топологические возбуждения в конфигурации фаз) или спиновыми волнами (осцилляции фаз малой амплитуды). В ансамбле вихрей при температуре Т_{КТ} происходит фазовый переход, при котором пары вихрь-антивихрь диссоциируют. Переход отделяет сверхпроводящую низкотемпературную фазу от резистивной высокотемпературной фазы. Перезарядка островов, вызванная туннелированием нормальных носителей, понижает температуру развязывания вихрей. В рассматриваемом пределе малых СП-островов заряды сильно флуктуируют и могут испытывать непрерывные



Рис. 5. *а* — температурная зависимость ас-диэлектрической проницаемости $\varepsilon_{ac}(T)$ вблизи критической температуры $T_{EHL} \approx T_{c0}$ конценсации металлических капель в образце $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ с концентрацией самария y = 0.8 в нулевом внешнем магнитном поле. *b* — аномальный гистерезис температурной зависимости ас-диэлектрической проницаемости $\varepsilon_{ac}(T)$ вблизи критической температуры $T_{EHL} \approx T_{c0}$ конденсации металлических капель в образце $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ с концентрацией самария y = 0.8 в нулевом внешнем магнитном поле. *b* — аномальный гистерезис температурной зависимости ас-диэлектрической проницаемости $\varepsilon_{ac}(T)$ вблизи критической температуры $T_{EHL} \approx T_{c0}$ конденсации металлических капель в образце $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ с концентрацией самария y = 0.9.

изменения. При этом они могут индуцировать член кинетической энергии для вихрей, который нелокален, но остается короткодействующим. Согласно [42], в пределе сильных флуктуаций заряда становится возможным появление вихрей с необычной геометрией. Авторы [41] разработали модель дискретной решетки для описания развязывания вихрей в 2D-сетках слабых связей, которая хорошо описывает также свойства гранулярных систем. Квадратная сетка из сверхпроводящих островов, связанных джозефсоновским взаимодействием, описывается гамильтонианом: $H = \sum_{ij} E_j(T) [1 - \cos(\Phi_i - \Phi_j)],$ где E_i — энергия джозефсоновской связи, $\Phi_i - \Phi_i$ разность фаз параметра порядка на двух соседних островах. Модель 2D-дискретной решетки изоморфна ХҮ модели с зависящей от температуры энергией связи (обзор фрустрированных ХҮ моделей можно найти

в [43]). Если в случае однородной пленки энергия

связи пары вихрь-антивихрь $U = \pi h/m^* n_S(T) \ln(r_2/r_1)$, то энергия связи 2D-вихрей в островах выражается как $U = \pi E_j \ln(r_2/r_1)$.

Предположение о появлении сильных флуктуаций заряда в *ab*-плоскостях в образцах с y > 0.8 с ростом концентрации самария подтверждается результатами исследования температурных зависимостей ас-диэлектрической проницаемости $\varepsilon_{ac}(T)$ на частоте 1 kHz вблизи температуры конденсации электрон-дырочной жидкости $T_{\rm EHL}$ в виде наномасштабных металлических капель, подробно рассмотренных ранее в работах [36].

Как видно из рис. 5, небольшое увеличение концентрации Sm привело к появлению температурного гистерезиса кривых $\varepsilon_{ac}(T)$. Более того, кривые $\varepsilon_{ac}(T)$ образца с у = 0.9 содержат аномалию диэлектрической проницаемости, возникающую вблизи критической температуры $T_{c0} \cong 55 \,\mathrm{K}$ только при понижении температуры образца. Аналогичный аномальный гистерезис наблюдался в изотермах полевых зависимостей намагниченности монокристаллов ВSCCО вблизи их перехода в СП-состояние [44]. Авторы предположили, что аномальный гистерезис вызван существованием сильных 2D-вихревых флуктуаций сверхпроводимости в СиО2-слоях. Обнаруженный в настоящей работе аномальный гистерезис диэлектрической проницаемости в нулевом внешнем магнитном поле, по-видимому, связан с сильными флуктуациями заряда в аb-плоскостях, вызванными резким уменьшением размеров СП-наноячеек с ростом концентрации самария.

Большой интерес представляет показанное на рис. 5, *а* и 5, *b* совпадение критических температур T_{c0} и T_{EHL} . Это позволяет предположить, что одной из основных причин появления высокотемпературной сверхпроводимости в образцах $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ (y = 0.85, 1.0) при $T < T_{c0}$ является формирование наномасштабных капель металлической электрон-дырочной жидкости в виде отдельных СП-наноячеек, возникающих в образцах при температурах ниже 60 К в результате бозе-эйнштейновской конденсации газа электрон-дырочных возбуждений.

Заключение

Таким образом, полученные в настоящей работе результаты исследования температурных зависимостей намагниченности керамических образцов фрустрированных манганитов $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ (y = 0.85, 1.0) в интервале температур 4.2-100 К можно объяснить в рамках существующих представлений о поведении 2D-сетки джозефсоновских слабых связей во внешнем магнитном поле в широком интервале изменений температуры сверхпроводящего композита. Серии периодических скачкообразных особенностей кривых намагниченности M(T), возникающих при температурах ниже 60 К, можно рассматривать как тепловые возбуждения сверхпроводящей жидкости в отдельных 2D-сверхпроводящих

наноячейках в ab-плоскостях из квантового состояния $n\Phi_0$ в вышележащее состояние $(n + 1)\Phi_0$, индуцированные ростом температуры образца.

В настоящей работе впервые обнаружен и исследован характерный признак топологического фазового перехода Костерлитца-Таулесса развязывания 2D-вихревых пар в виде серповидной аномалии дополнительной намагниченности вблизи $T_{\rm KT} \equiv T_c$ перехода сетки 2D-наноячеек в когерентное сверхпроводящее состояние. Предполагается, что найденная сингулярность температурных зависимостей намагниченности M(T), измеренных в dc-магнитных полях 100 и 350 Ое, вызвана экспоненциальным спадом плотности критического тока $i_c(T)$ в сверхпроводящей 2D-сетке джозефсоновских связей при температурах $T > T_{\rm KT}$, подобному хорошо известному падению $i_c(T)$ в 2D-искусственных сверхпроводящих построениях с джозефсоновскими контактами. Найденное аномально сильное уменьшение T_{KT} от значения 43 K до 12 K при незначительном росте у от 0.85 до 1.0 можно объяснить появлением и развитием "гигантских" флуктуаций заряда в ав-плоскостях, вызванных сильным уменьшением размеров (разориентацией) СП-наноячеек в 2D-сетке джозефсоновских связей. Это предположение подтверждается появлением аномального гистерезиса в температурных зависимостях ас-диэлектрической проницаемости в образце с y = 0.9 при температурах чуть выше $T_{c0} \sim 55 \,\mathrm{K}$. Увеличение сильных флуктуаций заряда в аb-плоскостях проявляется также в росте параметра, определяющего область критических СП-флуктуаций — $\tau_{\rm KT} = (T_{c0} - T_{\rm KT})/T_{\rm KT}$ в образцах с y = 0.85 ($\tau_{\text{KT}} \approx 2 \cdot 10^{-1}$) и 1.0 ($\tau_{\text{KT}} \approx 8 \cdot 10^{-1}$) с ростом концентрации самария. Относительно большую величину области критических флуктуаций в исследованных образцах можно объяснить беспорядком СП-наноструктуры в виде случайных разориентаций СП-наноячеек в ав-плоскостях, что приводит к росту эффективной анизотропии всей системы. Наличие признаков КТ-перехода в манганитах La_{1-v}Sm_vMnO_{3+δ} (y = 0.85, 1.0) и большая величина параметра $\tau_{\rm KT}$ свидетельствуют об эффективной квазидвумерности электронных и магнитных свойств этих образцов. Сравнение полученных в настоящей работе экспериментальных результатов с результатами теоретического и экспериментального исследования аномалий магнитных и резистивных свойств в сверхпроводящих купратах вблизи ТКТ указывает на близость ВТСП сверхпроводимости образцов $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ (y = 0.85, 1.0) и $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ ($\delta \le 0.1$). Предполагается, что наномасштабная 2D-сетка джозефсоновских связей возникает в исследованных образцах при $T < T_{\rm KT}$ в виде текстуры, характерной для электронных жидких кристаллов.

В работе обнаружена близость критических температур начала появления сверхпроводимости T_{c0} в отдельных СП-наноячейках и температуры конденсации электрон-дырочной жидкости T_{EHL} . Это позволяет предположить, что одной из основных причин появления локальной высокотемпературной сверхпроводимости в образцах $La_{1-y}Sm_yMnO_{3+\delta}$ (y = 0.85, 1.0) является формирование наномасштабных металлических капель электрон-дырочной жидкости в виде отдельных СП-наноячеек, возникающих в *ab*-плоскостях в результате бозе-эйнштейновской конденсации газа электрон-дырочных тепловых возбуждений.

Авторы работы благодарны сотрудникам нашего института С.В. Васильеву, В.И. Каменеву и В.П. Дьяконову, а также сотрудникам физико-технического института низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины Е.Н. Хацько, А.С. Черному и А.И. Рыковой за оказанную помощь.

Список литературы

- [1] Kosterlitz J.M., Thouless D.J. // J. Phys. C. 1972. Vol. 5. P. L124–L126.
- [2] *Kosterlitz J.M., Thouless D.J. //* J. Phys. C. 1973. Vol. 6. P. 1181–1203.
- [3] Kosterlitz J.M. // J. Phys. C. 1974. Vol. 7. P. 1046-1060.
- [4] Nelson D.R., Kosterlitz J.M. // Phys. Rev. Lett. 1977. Vol. 39.
 P. 1201–1205.
- [5] Rudnick I. // Phys. Rev. Lett. 1978. Vol. 40. P. 1454-1455.
- [6] Bishop D.J., Reppy J.D. // Phys. Rev. Lett. 1978. Vol. 40. P. 1727–1729.
- [7] Ambegaokar V., Halperin B.I., Nelson D.R., Siggia E.D. // Phys. Rev. B. 1980. Vol. 21. P. 1806–1826.
- [8] Pearl J. // Appl. Phys. Lett. 1964. Vol. 5. P. 65-66.
- [9] Beasley M.R., Mooij J.E., Orlando T.P. // Phys. Rev. Lett. 1979. Vol. 42. P. 1165–1168.
- [10] Halperin B.I., Nelson D.R. // J. Low Temp. Phys. 1979. Vol. 36. P. 599–616.
- [11] Kadin A.M., Epstein K., Goldman A.M. // Phys. Rev. B. 1983.
 Vol. 27. P. 6691–6702.
- [12] Hebard A.F., Fiory A.T. // Phys. Rev. Lett. 1980. Vol. 44. P. 291–293.
- [13] Lozovik Yu.E., Akopov S.G. // Sol. Stat. Commun. 1980. Vol. 35. P. 693–697.
- [14] Bancel P.A., Gray K.E. // Phys. Rev. Lett. 1981. Vol. 46. P. 148–151.
- [15] Epstein K., Goldman A.M., Kadin A.M. // Physica B+C. 1982. Vol. 109–110, P. 2087–2089.
- [16] Epstein K., Goldman A.M., Kadin A.M. // Phys. Rev. B. 1982. Vol. 26. P. 3950–3953.
- [17] Hebard A.F., Fiory A.T. // Physica B + C. 1982. Vol. 109–110.
 P. 1637–1648.
- [18] Hebard A.F., Fiory A.T. // Phys. Rev. Lett. 1983. Vol. 50.
 P. 1603–1606.
- [19] Fiory A.T., Hebard A.F., Gierson W.I. // Phys. Rev. B. 1983. Vol. 28. P. 5075.
- [20] Hebard A.F., Kotliar G. // Phys. Rev. B. 1989. Vol. 39. P. 4105.
- [21] Stamp P.C.E., Forro L., Ayache C. // Phys. Rev. B. 1988. Vol. 38. P. 2847.
- [22] Dubson M.A., Herbert S.T., Calabrese J.J., Harris D.C., Puttonand B.R., Garland J.C. // Phys. Rev. Lett. 1988. Vol. 60. P. 1061–1064.
- [23] Kim J., Lee H., Chung J., Shin H.J., Lee H.J. // Phys. Rev. B. 1991. Vol. 43. P. 2962–2967.

- [24] Mikheenko P.N., Aboliosheva I.S. // Physica C. 1993. Vol. 214. P. 393–402.
- [25] Srivastava P.K., Debely P., Hintermann H.E., Leemann C., Weber J., Caccivio O., Martinoli P., Ott H.R. // Physica C. 1988. Vol. 153–155. P. 1443–1444.
- [26] Gasparov V.A. // Physica C. 1991. Vol. 178, P. 449-455.
- [27] Martin S., Fiory A.T., Fleming R.M., Espinosa G.P., Cooper A.S. // Phys. Rev. Lett. 1989. Vol. 62, P. 677–680.
- [28] Cataudella V., Minnhagen P. // Physica C. 1990. Vol. 166. P. 442–450.
- [29] Yeh N.C., Tseuei C.C. // Phys. Rev. B. 1989. Vol. 39. P. 9708– 9711.
- [30] Глазман Л.И., Кошелев А.Е. // ЖЭТФ. 1990. Т. 97. Вып. 4. С. 1371–1378.
- [31] Остроумов Н.Н., Соколов А.И. // ФТТ. 1955. Т. 37. Вып. 9. С. 2635–2638.
- [32] Fisher D.S., Fisher M.P.A., Huse D.A. // Phys.Rev. B. 1991. Vol. 43. P. 130–159.
- [33] Артеменко С.Н., Горлова И.Г., Латышев Ю.И. // Письма в ЖЭТФ. 1989. Т. 49. Вып. 6. С. 352–355.
- [34] Артеменко С.Н., Горлова И.Г., Латышев Ю.И. // Письма в ЖЭТФ. 1989. Т. 49. Вып. 10. С. 566–569.
- [35] Горлова И.Г., Латышев Ю.И. // Письма в ЖЭТФ. 1990. Т. 51. Вып. 4. С. 197–200.
- [36] Буханько Ф.Н., Буханько А.Ф. // ФТТ. 2015. Т. 57. Вып. 6.
 С. 1098–1111; Буханько Ф.Н., Буханько А.Ф. // ФТТ. 2016.
 Т. 58. Вып. 3. С. 506–518.
- [37] Солимар Л. Туннельный эффект в сверхпроводниках и его применение. М.: Мир, 1974. 428 с.
- [38] Darhmaoui H., Jung J. // Phys.Rev. B. 1998. Vol. 57. P. 8009– 8025.
- [39] Etheridge J. // Philos. Mag. A. 1996. Vol. 73. P. 643-668.
- [40] Abraham D.W., Lobb C.J., Tinkham M., Klapwijk T.M. // Phys. Rev. B. 1982. Vol. 26. P. 5268–5271.
- [41] Lobb C.J., Abraham D.W., Tinkham M. // Phys. Rev. B. 1983.
 Vol. 27. P. 150–157.
- [42] Fazio R., Schon G. // Phys. Rev. B. 1991. Vol. 43. P. 5307– 5320.
- [43] Коршунов С.Е. // УФН. 2006. Т. 176. Вып. 3. С. 233–274.
- [44] Pradhan A.K., Roy S.B., Chaddah P., Chen C., Wanklyn B.M. // Phys. Rev. B. 1995. Vol. 52. P. 6215–6218.